

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : **04-218764**
 (43)Date of publication of application : **10.08.1992**

(51)Int.Cl.

G01N 27/82
 G01R 33/035
 G01R 33/14

(21)Application number : **02-239061**

(71)Applicant : **HITACHI LTD**

(22)Date of filing : **11.09.1990**

(72)Inventor : **OTAKA MASAHIRO**

TAKAKU KAZUO
SUTEEBUN EBANSON
HASEGAWA KUNIO

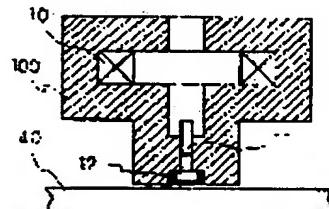
(54) DETECTING DEVICE OF DETERIORATION AND DAMAGE OF METAL MATERIAL

(57)Abstract:

PURPOSE: To enable precise and nondestructive detection of the degree of deterioration and the degree of damage of a material to be inspected, by impressing a minute alternating-current magnetic field on the material locally while impressing thereon a direct-current magnetic field widely and uniformly, and by detecting a change in the magnetic flux density of the material.

CONSTITUTION: A direct-current magnet 10, a magnetic sensor 11 and a small-sized alternating-current magnet 12 are arranged from above and put in one body by a sensor holder 100 formed of a nonmagnetic insulative material. A minute alternating-current magnetic field is impressed for excitation on a material 40 pipe to be inspected, by the magnet 12 disposed near the material 40, while a base magnetic field is impressed on the material by the magnet 10.

The magnet 12 is driven by a low frequency of several hertz or below on the occasion so as to prevent generation of an eddy current. Then, a minute change in magnetism accompanying deterioration and damage of the material 40 to be inspected is detected by the magnetic sensor 11 and the degree of deterioration and the degree of damage of the material 40 are determined from data on the change.



BEST AVAILABLE COPY

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

⑫ 公開特許公報 (A) 平4-218764

⑬ Int. Cl.⁵G 01 N 27/82
G 01 R 33/035
33/14

識別記号

ZAA

庁内整理番号

9118-2J
8203-2G
8203-2G

⑭ 公開 平成4年(1992)8月10日

審査請求 未請求 請求項の数 10 (全11頁)

⑮ 発明の名称 金属材料の劣化損傷検出装置

⑯ 特 願 平2-239061

⑰ 出 願 平2(1990)9月11日

⑱ 発明者 大高 正廣 桃城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

⑲ 発明者 高久 和夫 桃城県日立市幸町3丁目1番1号 株式会社日立製作所日立工場内

⑳ 発明者 ステーブン エバンソン 桃城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

㉑ 発明者 長谷川 邦夫 桃城県土浦市神立町502番地 株式会社日立製作所機械研究所内

㉒ 出願人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

㉓ 代理人 弁理士 秋本 正実

明細書

1. 発明の名称

金属材料の劣化損傷検出装置

2. 特許請求の範囲

1. 測定体に励磁コイル等により磁界を印加し、それによって測定体に生じる磁気変化から測定体の劣化および損傷を検出する金属材料の劣化損傷検出装置において、測定体に直流磁界を印加する直流マグネットと、測定体に微小な交流磁界を印加する交流マグネットと、測定体の磁気変化を検出する磁気センサと、その測定体の磁気変化の測定データから劣化度および損傷度を判定する演算処理装置とを備えたことを特徴とする金属材料の劣化損傷検出装置。

2. 直流マグネットと交流マグネットを磁気センサ等を一体として、測定体上を走査できる走査装置を設けたことを特徴とする請求項1記載の金属材料の劣化損傷検出装置。

3. 測定体表面上に小型の交流マグネットと磁気センサを配置し、その上部に直流マグネットを

配置したことを特徴とする請求項1または請求項2記載の金属材料の劣化損傷検出装置。

4. 直流マグネットに馬蹄形ヨークを備え、測定体の漏れ磁界を検出するように磁気センサを配置したことを特徴とする請求項2記載の金属材料の劣化損傷検出装置。

5. 直流マグネットの励磁電源に微小交流成分を付加して直流・交流マグネットとしたことを特徴とする請求項1または請求項2記載の金属材料の劣化損傷検出装置。

6. 直流マグネットに超電導体マグネットを備え、磁気センサにS Q U I Dセンサを備えたことを特徴とする請求項1または請求項2記載の金属材料の劣化損傷検出装置。

7. 交流マグネットを銅等の常電導材料で構成し、クライオスタット外部の室温環境で動作させることを特徴とする請求項6記載の金属材料の劣化損傷検出装置。

8. 直流マグネットと交流マグネットによって形成される磁界において磁束密度Bが $\frac{\partial B}{\partial x} = 0$

となる位置xに差動型の磁気センサを配置し、励磁コイルの成分をキャンセルして測定体の磁気変化のみを検出できるようにしたことを特徴とする請求項1から請求項7のいずれか1項に記載の金属材料の劣化損傷検出装置。

9. 交流マグネットの電源にパルス出力の可能な電源を用いることを特徴とする請求項1から請求項8のいずれか1項に記載の金属材料の劣化損傷検出装置。

10. 直流マグネットの直流磁界をステップ状または連続的に変えながら、交流マグネットの微小な交流磁界での測定体の磁気特性を磁気センサで測定し、その測定値と予め求めておいたデータベースの値との比較から演算処理装置で測定体の劣化度および損傷度を判定することを特徴とする請求項1から請求項9のいずれか1項に記載の金属材料の劣化損傷検出装置。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は金属材料の劣化および損傷を検出する

である。しかし475℃脆性が400℃以下の温度範囲においても長時間使用中に生じる可能性があるため、含フェライト系ステンレス鋼の実機部材の高温での使用にはさらに十分の配慮が必要であるが、上記従来技術は500℃以下の脆化およびひずみがある場合のひずみ時効についての配慮がされておらず、475℃脆性の程度を検出できない問題があった。

上記従来技術はまた実機溶接部の初期フェライト量が溶接位置で異なるうえばらつきも大きく、さらに実機では溶接箇所が膨大であるため、全部の溶接部および機器材料の初期のフェライト量を全て監視することが困難であり、したがって上記従来技術は初期フェライト量が不明な箇所には適用できないため、実機で実用化できないという問題があった。

本発明は高温環境下で使用する含フェライト系ステンレス鋼および低合金鋼等の金属材料の実機部材の脆化およびひずみ損傷の程度を非破壊的にかつ精度よく検知できる金属材料の劣化損傷検出

装置に係り、特に原子力プラントおよび化学プラントの高温環境下で使用される含フェライト系ステンレス鋼および低合金鋼等の金属材料の実機部材における高温時効脆化およびひずみ損傷等を検知するに好適な金属材料の劣化損傷検出装置に関する。

【従来の技術】

従来の金属材料の脆化検出方法の一例としては、特開昭54-61981号公報に記載のような方法がある。この方法ではオーステナイト系ステンレス溶接金属の脆化の有無を初期のフェライト量が5%以上減少したことで判定するとしている。

【発明が解決しようとする課題】

上記従来技術は高温で使用される金属材料のうちで特に含フェライト系ステンレス鋼を例にとれば高温長時間の使用により時効脆化を起こすことが既に知られており、これはおよそ600℃以上の比較的高温においてはα相の析出に起因する。脆化が生じ、また400℃から500℃の範囲ではいわゆる475℃脆性が生じることによるもの

装置を提供することを目的とする。

【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するために、本発明の金属材料の劣化損傷検出装置は測定材料の磁気特性を示す磁気ヒステリシスループの微小領域の変化を測定し、 $\Delta B / \Delta H$ 量から測定材料の熱時効劣化やひずみ損傷等を検出し、こうした測定材料の磁気特性から材料の劣化および損傷の程度を判定しようとするものであり、この測定材料の磁気特性を示す磁気ヒステリシスループの $\Delta B / \Delta H$ を測定するためには測定材料に直流磁界を印加する直流マグネットと微小交流磁界を印加する小型交流マグネットと磁気を測定する差分型等の磁気センサとを組み合せたセンサ部を備え、さらにセンサ部の測定データから材料の劣化度および損傷度を判定するためには演算処理装置を備えたものである。

また実プラントの機器材料の検査のためにはセンサ部を機器上で走査するために走査装置を含めたシステムにしたものである。

上記センサ部としては被検体に直流磁界を広範

周で均一に印加し、微小交流磁界を局所的に印加するために、被検体側から小型交流マグネットと磁気センサと直流マグネットの順に配置したものである。

また被検体への励磁を効率よく行なうためと横方向励磁を行うために、馬蹄形ヨークを用いたセンサとしたものである。

またセンサ構造を簡略化するために、直流マグネットの励磁電流に直流成分に加えて微小交流成分を付加したものとし、小型交流マグネットを除去したものである。

また微小交流磁界だけを高感度に検出するためには、磁気センサを差動型にしたものである。

また非接触で高感度測定するために磁気センサに S Q U I D (超電導量子干渉素子) センサを用い、直流マグネットに超電導マグネットを用いたものである。

上記演算処理装置としては被検材の劣化度および損傷度を推定するために、磁気ヒステリシスループの $\Delta B / \Delta H$ や $\Delta B / \Delta H$ カーブのパラメー

タを統計的に処理するものである。

[作用]

上記金属材料の劣化損傷検出装置の動作原理および作用を第 1 3 図の金属材料の B - H カーブを用いて説明する。金属材料は高温環境中で長時間使用すると、内部組織に変化を生じて強度が低下する。このとき内部組織の変化に伴い電気抵抗率 ρ や透磁率 μ などの電磁気的特性も変化することが知られている。

しかし実プラントでは運転温度が比較的低いため、熱時効による脆化度が小さく、電磁気的特性の変化も小さい。そこで発明者らは第 1 3 図に示すように微小磁気ヒステリシス量の $\Delta B_i - \Delta H_i$ 特性を測定した結果、特に材料の時効脆化と直流磁界 H_i のときの $\Delta B_i - \Delta H_i$ 特性とがよく対応することを見出した。

また含フェライト系ステンレス鋼や低合金鋼等の金属材料に加工による塑性ひずみを加えると、その塑性ひずみ量に依存して材料の $\Delta B - \Delta H$ の磁気特性が変化する。さらに予めひずみを与えた

材料を時効させた場合も同様にひずみ時効の程度に対応した $\Delta B - \Delta H$ の磁気特性の変化が得られた。

すなわち、このような現象を利用すれば、含フェライト系ステンレス鋼および低合金鋼等の金属材料の時効脆化および加工ひずみの進行程度を精度よく検知することができる。

そこで本装置では、直流マグネットは第 1 3 図に示すようにベース磁界 H_i を被検材に印加する。また小型交流マグネットは被検材に微小交流磁界 ΔH_i を印加するものである。このときの微小交流磁界 ΔH_i による被検材の磁束密度変化 ΔB_i を磁気センサで検出する。それによって劣化損傷材の $\Delta B - \Delta H$ の微小磁気ヒステリシス特性が測定できる。演算処理装置は測定した磁気特性のデータから被検材の劣化度および損傷度を予め用意したデータベースと比較して推定できる。それによって被検材の劣化度および損傷度が検出が可能となる。

また走査装置は検査対象機器材上でセンサ部を

走査するもので、それによって実プラントでの測定および検査が可能である。

上記センサ部に馬蹄形ヨークを用いることにより、横磁界および効率よい磁界の励磁ができる。また直流マグネットに印加する励磁電流に直流成分と微小交流成分を重畳することでも同様の作用が得られる。

またセンサ部に S Q U I D (超電導量子干渉素子) センサと超電導マグネットと小型交流常電導マグネットを組み合わせても、同様の作用が非接触で得られる。また磁気センサを差動型にすることにより、直流成分をキャンセルして微小交流成分のみを高感度で測定できる。

[実施例]

以下に本発明の実施例を第 1 図から第 2 1 図により説明する。

第 1 図は本発明による金属材料の劣化損傷検出装置の一実施例を示す全体システム構成斜視図である。第 1 図において、被検体 (パイプ) 4 0 は原子力プラント等に用いられている配管等の被検

体であり、被検体（パイプ）40の溶接部41の劣化損傷状態を検出する。このため直流マグネット10と磁気センサ11と小型交流マグネット12から構成されるセンサ部70が溶接部41の上に配置される。センサ部70はセンサ用バー53を介して走査装置50に取り付けられており、センサ用バー53の伸縮によりセンサ部70はパイプ40の軸方向へ走査が可能である。またパイプ40にはスタンド52によりレール51が固定されており、走査装置50はレール51上を移動することができる。すなわちセンサ部70は走査装置50によりパイプ40の軸方向と周方向の走査が可能である。走査装置50は走査制御装置60で位置制御される。センサ部70の直流マグネット10、磁気センサ11、小型交流マグネット12はそれぞれ直流電源20、センサコントローラ21、交流電源22に接続される。直流電源20とセンサコントローラ21と交流電源22はコンピュータ30に接続され、測定結果はコンピュータ30のディスプレー31および出力装置32に

表示される。

第1図のセンサ部70の実施例の詳細を第2図から第10図により次に説明する。

第2図は第1図のセンサ部70の第1の実施例を示す詳細断面図である。第2図において、同軸型センサ部70の実施例を示す。被検体40の表面近傍に小型交流マグネット12を配置して被検体40を励磁する。このとき被検体40に渦電流が発生しないように、数Hz以下の低周波数で小型交流マグネット12を駆動する。被検体（パイプ）40の劣化損傷に伴う微小磁気変化は小型交流マグネット12の上部に配置した磁気センサ11で検出する。被検体40にベース磁界を印加する直流マグネット10は磁気センサ11のさらに上部にある。直流マグネット10と磁気センサ11と小型交流マグネット12は非磁性・絶縁材料からなるセンサホルダー100で一体化されている。

第3図は第1図のセンサ部70の第2の実施例を示す詳細断面図である。第3図において、被検

体40の磁気異方性を検出するためのセンサ部70の実施例を示す。馬蹄形のヨーク13に直流マグネット10を巻きつけ、さらに小型交流マグネット12を巻きつけてある。磁気センサ11aはヨーク13の中央で被検体（パイプ）40の漏れ磁界を測定する。また磁気センサ11bはヨーク13の一方の端に配置して被検体40の直接の磁界を測定する。ヨーク13と直流マグネット10と小型交流マグネット12と磁気センサ11a、11bはセンサホルダー100で一体化されている。

第4図は第1図のセンサ部70の第3の実施例を示す詳細断面図である。第4図において、直流マグネット10と磁気センサ11からなり、直流マグネット10の直流電源20に交流電源22の微小交流成分が付加できる機能をもたせた励磁電源20'を接続したセンサ部70の実施例を示す。この実施例により小型交流マグネット12が除去できる。直流マグネット10と磁気センサ11はセンサホルダー100で一体化されている。

第5図(a)、(b)は第2図から第4図の磁気センサ11、11a、11bの一実施例を示す詳細配置図および出力波形図である。第5図(a)、(b)において、第5図(a)の磁気センサ11A、11BをZ軸方向に距離 ΔZ だけ離して配置した差動型磁気センサ11の実施例を示す。直流マグネット10の直流磁界を印加した状態で小型交流マグネット12の微小な交流磁界を検出する場合に、ベース磁界（直流磁界）で磁気センサ11の出力が大きくなつて微小交流出力が得にくくなるから、そこで2つの磁気センサ11A、11Bを逆方向に接続してその差分量で交流成分だけを検出することにより、第5図(b)の磁気センサ11の交流出力波形が得られる。

第6図(a)、(b)は第2図から第4図の磁気センサ11、11a、11bの他の実施例を示す詳細配置図および出力波形図である。第6図(a)、(b)において、第6図(a)の2つの磁気センサ11A、11Bを用いて一方の磁気センサ11Aで直流磁界および小型交流マグネット12の交

流磁界を測定する、そして第6図(b)の2つの磁気センサ11b, 11Aの出力波形B, Aの差から交流成分を検出する。

第7図は第1図のセンサ部70の第4の実施例を示す詳細断面図である。第7図において、SQUIDセンサシステムおよび超電導マグネットを用いたセンサ部70の実施例を示す。第7図のクライオスタッフ113の内部には液体ヘリウムが充填されており、4.2Kに冷却されている。このクライオスタッフ113の中にSQUID110とピックアップコイル111と超電導マグネット101が納められる。磁界を検出するピックアップコイル111はSQUID110に接続されており、SQUID110で磁気量が電気信号に変換され、 $2.07 \times 10^{-15} \text{ Wb}$ の高感度で検出できる。SQUID110の出力はアンプ115で増幅され、SQUIDコントローラ116で処理される。ピックアップコイル111とSQUID110との間にヒートスイッチ112が設けてあり、超電導マグネット101の磁界変更時にはヒートスイッチ112をOFFにしてSQUID

生じる磁界について磁束密度Bの変化 $\frac{\partial B}{\partial x} = 0$ の位置xにピックアップコイル111を配置するものである。

第8図は第1図のセンサ部70の第5の実施例を示す詳細断面図である。第8図において、第7図または第8図のSQUIDセンサを用いたセンサ部70について、交流磁界を印加するのに容易な常電導交流マグネット12を超電導マグネット101の外側に配置した実施例を示す。

第10図は第1図のセンサ部70の第7の実施例を示す詳細断面図である。第10図において、第7図または第8図のSQUIDセンサを用いたセンサ部70において、第9図の実施例とは逆に常電導交流マグネット12を超電導マグネット101の内側に配置した実施例を示す。

第7図から第10図のSQUIDセンサシステムおよび超電導マグネットを用いたセンサ部70の実施例について、最近に液体窒素温度で動作する高温超電導材料が開発されており、この高温超電導材料を応用した高温SQUIDが実現できれ

110に入る磁界をカットし、SQUID110を保護する。クライオスタッフ113の下部には交流磁界を印加するための小型常電導マグネット12が配置される。超電導マグネット101で安定した直流磁界を被検体40に印加し、小型交流マグネット12による交流磁界をSQUIDセンサで高感度に検出する。なおクライオスタッフ113内の上部には液体ヘリウム蒸発を防ぐための熱しゃへい板114がある。

第8図は第1図のセンサ部70の第5の実施例を示す詳細断面図である。第8図において、第7図のSQUIDセンサを用いたセンサ部70について超電導マグネット101と交流マグネット12と磁気検出のピックアップコイル111の配置を限定した実施例を示す。第8図のピックアップコイル111は通常に微分型コイルを用いる。これは外部磁界ノイズや励磁時のマグネット磁界をキャンセルするためである。従って被検体40の材料による磁界変化だけを検出するために、超電導マグネット101および交流マグネット12で

ば、第7図から第10図と同様のセンサ部70を実現することが可能となり、この場合には冷却に液体窒素が使用できるためSQUIDセンサの小型化が図れる。

第11図(a), (b)は第1図および第7図から第10図の直流電源20および交流電源22の出力波形の一実施例を示す説明図である。第11図(a), (b)において、第11図(a)の直流電源20の直流出力波形は一定出力を出力する波形Aの場合と、第11図(b)の交流電源22の交流出力波形の周期に比べてはるかに長い周期で変化する波形Bの場合を設定する。波形Aの場合は直流出力をステップ状に変化させて交流出力を微小ヒステリシスを測定し、波形Bの場合はこれを連続的に行なうものである。

第12図(a), (b)は第1図および第7図から第10図の直流電源20および交流電源22の出力波形の他の実施例を示す説明図である。第12図(a), (b)において、第12図(a)の直列電源20の直流出力波形は第11図の実施例と同

様であるが、第12図(b)の交流電源22の交流出力波形をパルス状の波形に設定する。このように交流出力をパルス状にすることにより、急変する磁気特性(磁区)の変化から被検体40の材料の損傷を検出しようとするもので、この交流マグネット12と直流マグネット10, 101の併用を行うものである。これによりバルクハウゼンノイズなどの磁区の微小な変化にも検出できる。

つぎに第1図から第12図の実施例の被検体40の接部41などの磁気測定および劣化損傷判定方法と動作を第13図から第21図により説明する。

第13図は第1図の被検体40の金属材料の磁気ヒステリシスループのB-Hカーブを示す説明図である。第13図においてB-Hカーブの①'→②'→③'の過程で励磁した後、直流磁界H₁で交流磁界△H₁を印加する。これにより磁束密度Bは△B₁だけ変化し、その時の△B₁-△H₁カーブは図示のようになる。つぎに直流磁界H₂に変えて同様に測定する。これを①の飽和磁界まで

成分Hとの関係を例示する測定結果の説明図である。第16図において、被検体40の材料のひずみ損傷度△B/△H-Hの変化パターンが矢印で示すように異なったパターンとなるため、この測定データをデータベースのマスター・カーブとして使用できる。

第17図は第1図の被検体40の金属材料の直流磁界Hをパラメータとして時効時間(aging time)とSQUID出力($\Delta B / \Delta H \approx \Delta \mu$)の関係を例示するSQUIDセンサおよび超電導マグネットを用いたセンサ部70による測定結果の説明図である。第17図において、SQUID110の出力($\Delta B / \Delta H \approx \Delta \mu$)は時効時間の増加に伴って減少する。また直流磁界H₁が大きいほど、SQUID110の出力($\Delta B / \Delta H \approx \Delta \mu$)は小である。

第18図は第17図の直流磁界H=0のときの時効時間に伴う△B/△Hカーブの変化を例示する測定結果の説明図である。第18図において、直流磁界H=0のときのSQUID出力の△B/

行い、さらに②'→③'と直流磁界を変化させ交流磁界を印加して△B-△Hカーブを測定する。

第14図は第13図のB-Hカーブの微小励磁領域での△B-△Hカーブを示す説明図である。第14図において、第13図に示した測定方法により得られる△B-△Hカーブを示し、直流磁界H_i(i=1, 2, 3, ...)に依存して△B-△Hカーブが図示のように変化する。この△B-△Hカーブのパターンが被検体40の材料の時効やひずみ損傷の程度により変化するものである。

第15図は第1図の被検体40の金属材料の処女材および時効材の△B/△Hと直流磁界成分Hとの関係を例示する測定結果の説明図である。第15図において、被検体40の材料の時効劣化度で△B/△H-Hの変化パターンが矢印で示すように異なったパターンとなるため、この測定データをデータベースのマスター・カーブとして使用できる。

第16図は第1図の被検体40の金属材料の処女材およびひずみ損傷材の△B/△Hと直流磁界

△Hカーブは時効時間t=0<t₁<t₂の増加に伴って図示のように変化する。

第19図は第1図の被検体40の金属材料の直流磁界Hをパラメータとしてひずみ損傷の負荷ひずみ量ε_p%とSQUID出力($\Delta B / \Delta H \approx \Delta \mu$)の関係を例示するSQUIDセンサおよび超電導マグネットを用いたセンサ部70による測定結果の説明図である。第19図において、SQUID110の出力($\Delta B / \Delta H \approx \Delta \mu$)は負荷ひずみ量ε_p%の増加に伴い増加したのち減少する。また直流磁界H₁が大きいほど、SQUID110の出力($\Delta B / \Delta H \approx \Delta \mu$)は小である。

第20図は第19図の直流磁界H=0のときの負荷ひずみ量ε_pによる△B-△Hカーブの変化を例示する測定結果の説明図である。第20図において、直流磁界H=0のときのSQUID出力の△B-△Hカーブは負荷ひずみ量ε₀=0<ε₁<ε₂の増加に伴って図示のように変化する。

第17図から第20図の測定データをデータベースのマスター・カーブや比較基準の△B-△Hカ

ープとして使用すれば、被検体40の実際の測定データの比較演算により被検体40の金属材料の時効劣化度およびひずみ損傷度が判定できる。

第21図は第1図から第12図の実施例の被検体40の溶接部41の磁気測定および劣化損傷判定の動作手順を例示するフローチャートである。第21図において、第1図に示すような装置を被検体(パイプ)40にセットした後、ステップ1で溶接部41の検査領域をまず第13図のB-Hカーブの飽和磁界まで励磁して磁気履歴を除去する。つぎにステップ2で測定する直流磁界H_iまで直流マグネット10, 101の磁界を減少させる。ついでステップ3で交流マグネット12による第13図の△B-△Hカーブをセンサ部70の磁気センサ11, 110で測定する。このステップ2, 3の過程を逆の飽和磁界に達するまで繰返す。つぎにステップ4で逆方向の飽和磁界と判定した場合に、ステップ5に移行して直流磁界H_i(i=1, 2, 3, ...)での△B-△Hカーブの測定データをメモリに保管する。ついでステッ

プ6でセンサ部70を移動して、ステップ1から再度測定する。ステップ6ですべての測定位置での検査が終了した後、ステップ7に移行して第15図から第20図のデータベースによる劣化損傷判定を行う。ついでステップ8で劣化損傷判定結果を出力装置32に表示する。

本実施例によれば、直流磁界に伴う微小交流磁界での△B-△Hカーブの変化を測定することにより、金属材料の劣化度および損傷度が検出できる。また変化させる交流磁界が小さい場合にも差動磁気センサの使用により高精度の測定ができる。特にSQUIDセンサを用いた場合には非接触で検出できる。

【発明の効果】

本発明によれば、高温で使用される金属材料の脆化の程度およびひずみ量を非破壊的にかつ迅速に検知できるので、機器の損傷を未然に防ぐことが可能となって実機の安全性を高めることができる効果がある。

4. 図面の簡単な説明

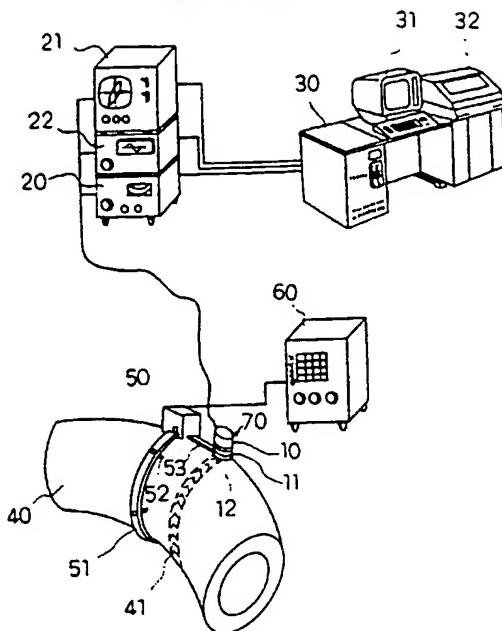
第1図は本発明による金属材料の劣化損傷検出装置の一実施例を示す全体システム構成斜視図。第2図は第1図のセンサ部の第1の実施例を示す詳細断面図、第3図は第1図のセンサ部の第2の実施例を示す詳細断面図、第4図は第1図のセンサ部の第3の実施例を示す詳細断面図、第5図(a), (b)は第2図から第4図の磁気センサの一実施例を示す詳細配置図および出力波形図、第6図(a), (b)は第2図から第4図の磁気センサの他の実施例を示す詳細配置図および出力波形図、第7図は第1図のセンサ部70の第4の実施例を示す詳細断面図、第8図は第1図のセンサ部の第5の実施例を示す詳細断面図、第9図は第1図のセンサ部の第6の実施例を示す詳細断面図、第10図は第1図のセンサ部の第7の実施例を示す詳細断面図、第11図(a), (b)は第1図および第7図から第10図の直流電源および交流電源の出力波形の一実施例を示す説明図、第12図(a), (b)は第1図および第7図から第10図の直流電源および交流電源の出力波形の他の実施

例を示す説明図、第13図は第1図の被検体の金属材料のB-Hカーブを示す説明図、第14図は第13図の△B-△Hカーブを示す説明図、第15図は第1図の被検体の金属材料の処女材および時効材の△B/△HとHとの関係を示す測定結果の説明図、第16図は第1図の被検体の金属材料の処女材およびひずみ損傷材の△B/△HとHとの関係を示す測定結果の説明図、第17図は第1図の被検体の金属材料のHをパラメータとして時効時間とSQUID出力の関係を示す測定結果の説明図、第18図は第17図のH=0のときの時効時間に伴う△B-△Hカーブの変化を示す測定結果の説明図、第19図は第1図の被検体の金属材料のHをパラメータとしてひずみ量とSQUID出力の関係を示す測定結果の説明図、第20図は第19図のH=0のときのひずみ量ε_pによる△B-△Hカーブの変化を示す測定結果の説明図、第21図は第1図から第12図の実施例の被検体の磁気測定および劣化損傷判定の動作手順を示すフローチャート

である。

10…直流マグネット、11…磁気センサ、12…小型交流マグネット、13…ヨーク、20…直
流電源、21…センサコントローラ、22…交流
電源、30…コンピュータ、31…ディスプレイ、
32…出力装置、40…被検材、41…溶接部、
50…走査装置、51…レール、52…スタンド、
53…センサ用バー、60…走査制御装置、70
…センサ部、100…センサホルダ、101…超
電導マグネット、110…SQUID、111…
ピックアップコイル、112…ヒートスイッチ、
113…クライオスタット、114…しゃへい板、
115…アンプ、116…SQUIDコントロー
ラ。

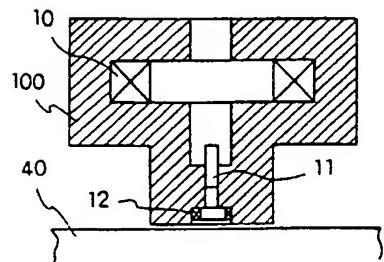
第 1 図



代理人 弁理士 秋 本 正 実

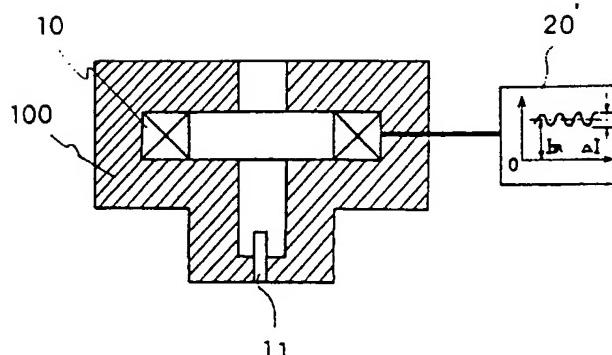
10: 直流マグネット	30: コンピュータ	51: V-ル
11: 磁気センサ	31: ディスプレイ	52: スタンド
12: 小型交流マグネット	32: 出力装置	53: センサ用バー
20: 直流電源	40: 検査体 パイプ	60: 走査制御装置
21: センサコントローラ	41: 溶接部	70: センサ部
22: 交流電源	50: 走査装置	

第 2 図

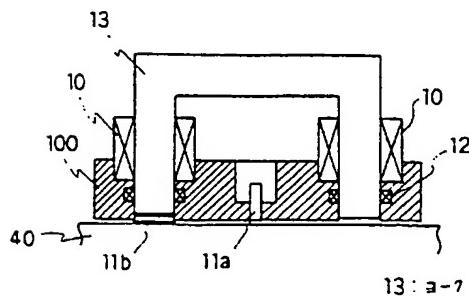


10: 直流マグネット
11: 磁気センサ 40: 検査材
12: 小型交流マグネット 100: センサホルダー

第 4 図

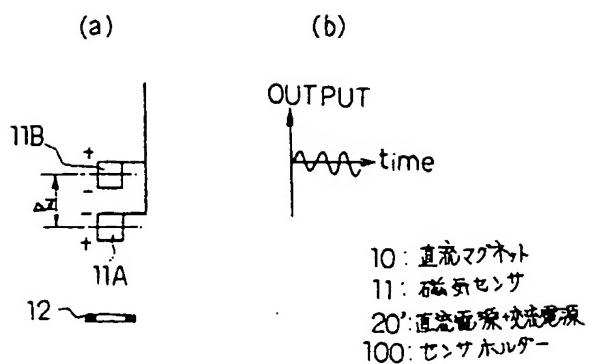


第 3 図

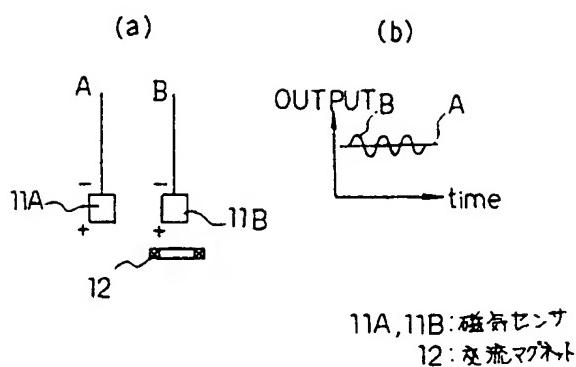


10: 直流マグネット
11: 磁気センサ
20: 直流電源+交流電源
100: センサホルダー

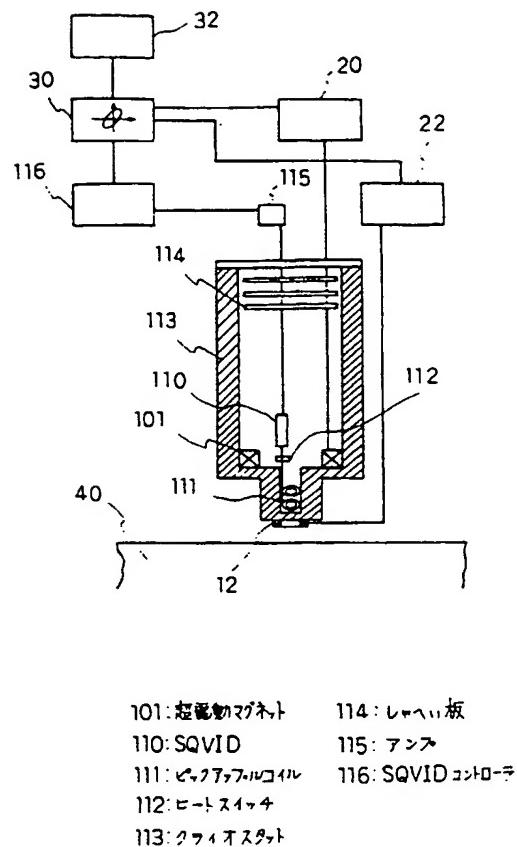
第 5 図



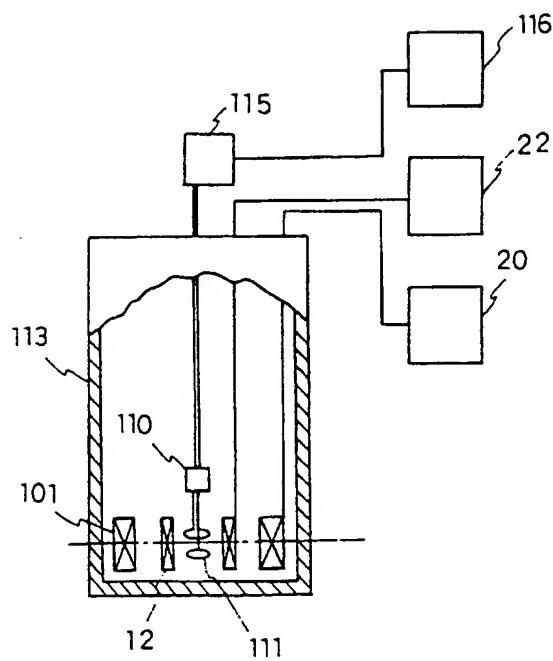
第 6 図



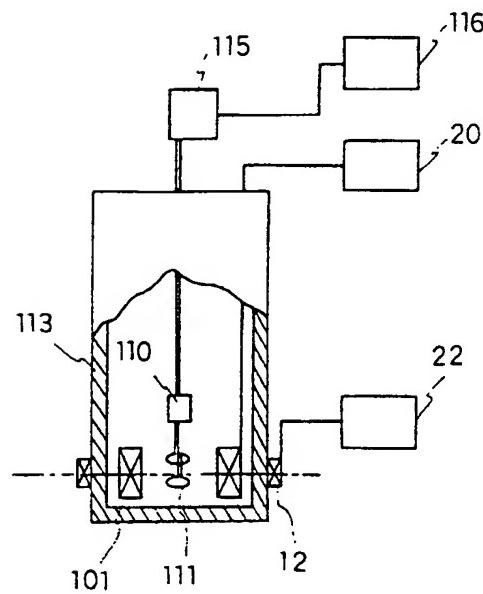
第 7 図



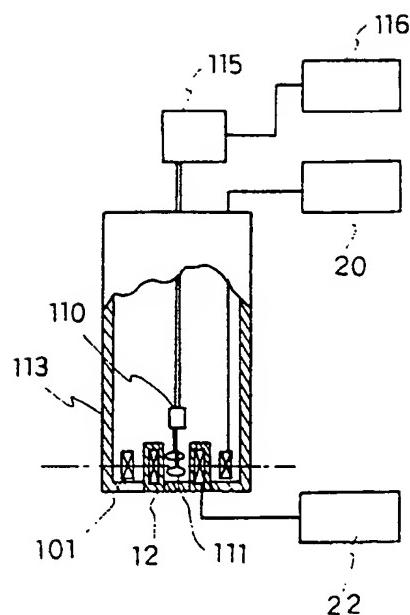
第 8 図



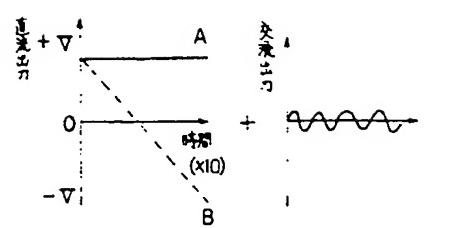
第 9 図



第 10 図

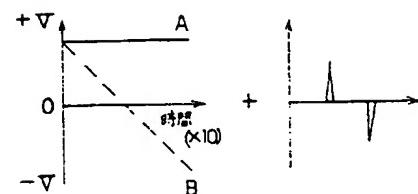


第 11 図



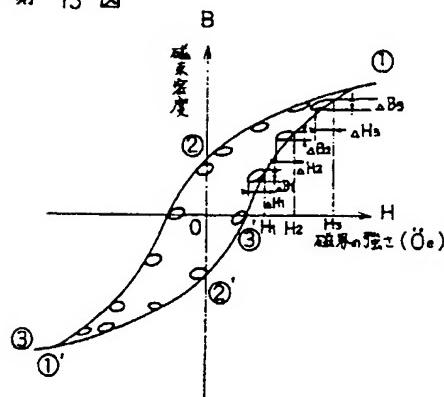
(a) 直流電源出力波形 (b) 交流電源出力波形

第 12 図

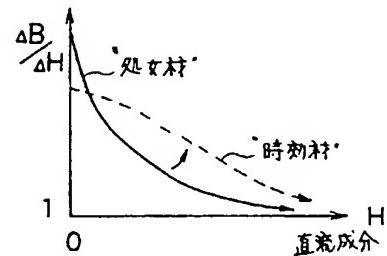


(a) 直流電源出力波形 (b) ハーフレス出力波形

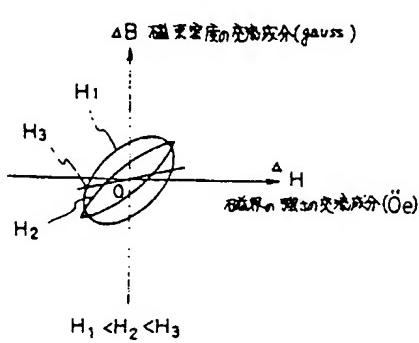
第 13 図



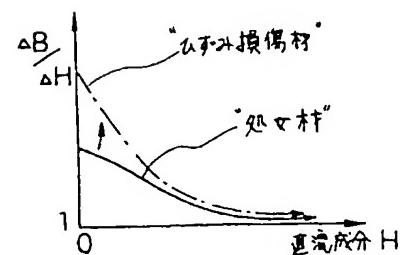
第 15 図



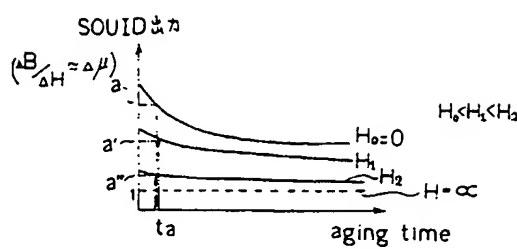
第 14 図



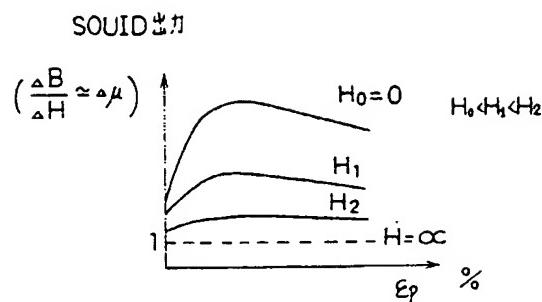
第 16 図



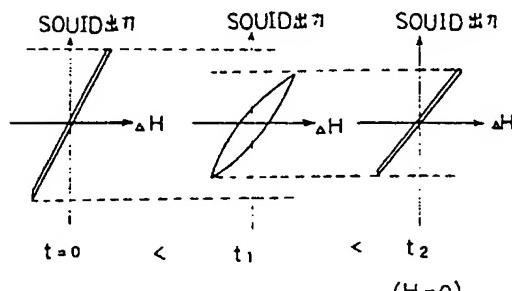
第 17 図



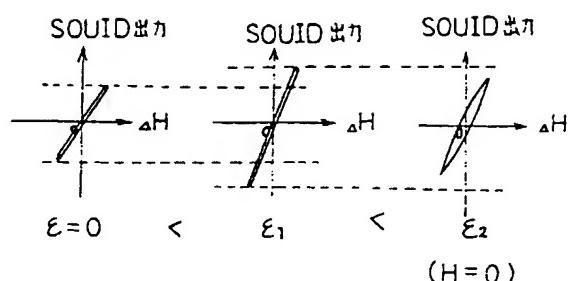
第 19 図



第 18 図



第 20 図



第 21 図

